

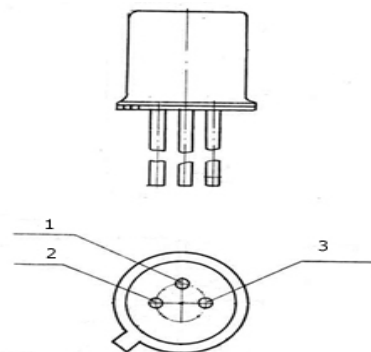
2ТЗ117А

**PNP КРЕМНИЕВЫЙ ЭПИТАКСИАЛЬНО – ПЛАНАРНЫЙ
ИМПУЛЬСНЫЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ТРАНЗИСТОР**

аАО.339.256 ТУ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ
В АППАРАТУРЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

* Изготавливается в корпусе **КТ1-7**.



1–База, 2–Эмиттер, 3–Коллектор

ПРЕДЕЛЬНО- ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры	Обозначение	Ед. измер.	Значение
Напряжение коллектор-база	Uкб max	В	60
Напряжение коллектор-эмиттер	Uкэ max	В	60
Напряжение эмиттер-база	Uэб max	В	4
Постоянный ток коллектора	Iк max	мА	400
Импульсный ток коллектора	Iки max	мА	800
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора	Pк max	Вт	0,3

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (Токр.ср.=25°С)

Параметры	Обозначение	Ед. измер	Режимы измерения	Min	Max
Обратный ток коллектора	Iкбо	мкА	Uкб=60В	0,01	5
Статический коэффициент передачи тока	h21E		Uкб=-5В, Iэ=200мА f=50Гц t _и ≤30мкс Q≥50	40	200
Напряжение насыщения коллектор- эмиттер	Uкэ(нас)	В	Iк=500мА, Iб=50мА	0,2	0,5
Напряжение насыщения база - эмиттер	Uбэ(нас)	В	Iк=500мА, Iб=50мА	0,6	1,2
Емкость коллекторного перехода*	Ск*	пФ	Uкб=10В, Iэ=0, f=10 ⁷ Гц	7	10
Емкость эмиттерного перехода*	Сэ*	пФ	Uэб=0В f=10 ⁷ Гц	40	80
Обратный ток эмиттера	Iэбо	мкА	Uэб= 4 В	0,01	5

· Справочные параметры

220108, г. Минск, ул. Корженевского, 16, УП "Завод ТРАНЗИСТОР"

Отдел маркетинга: тел./факс (10-37517) 212-59-32

E-mail: market@transistor.com.by; <http://www.transistor.by>